

Список публикаций Аверкиева Н.С. (официальный оппонент)

1. Nikolaev V.V., **Averkiev N.S.**, Kaliteevski M.A., Quantum confinement explains pump-dependent luminescence from butyl-terminated Si quantum dots, *Journal of Physical Chemistry C* **123**, 27854 (2019).
2. Моисеев К.Д., Березовец В.А., Голеницкий К.Ю., **Аверкиев Н.С.**, Зонная структура гибридной электронно-дырочной системы на одиночной разьединенной гетерогранице II типа, *Физика низких температур* **45**, 179 (2019).
3. Богословский Н.А., Петров П.В., **Аверкиев Н.С.**, Влияние релаксации носителей заряда на спектры донорно-акцепторной рекомбинации с учетом кулоновских корреляций, *Физика низких температур* **45**, 171 (2019).
4. Bogoslovskiy N.A., Petrov P.V., Ivánov Y.L., Tsendin K.D., **Averkiev N.S.**, Two components of donor-acceptor recombination in compensated semiconductors: analytical model of spectra in the presence of electrostatic fluctuations, *Physical Review B* **98**, 075209 (2018).
5. Bushuykin P.A., Andreev B.A., Lobanov D.N., Kuritsyn D.I., Yablonskiy A.N., Krasilnik Z.F., Davydov V.Y., **Averkiev N.S.**, Savchenko G.M., New photoelectrical properties of InN: interband spectra and fast kinetics of positive and negative photoconductivity of InN, *Journal of Applied Physics* **123**, 195701 (2018).
6. Дмитриев Г.С., Крайнов И.В., Сапега В.Ф., **Аверкиев Н.С.**, Энергетическая структура одиночного акцептора Mn в GaAs : Mn, *ФТТ* **60**, 1556 (2018).
7. **Аверкиев Н.С.**, Гуткин А.А., Акцепторный центр MnGa в GaAs (о б з о р) , *ФТТ* **60**, 2275 (2018).
8. Дмитриев Г.С., Сапега В.Ф., **Аверкиев Н.С.**, Панайотти И.Е., Ploog К.Н., Влияние размерного квантования на спиновую поляризацию дырок в структурах с квантовыми ямами разбавленного магнитного полупроводника (Ga,Mn)As/AlAs, *ФТТ* **59**, 2240 (2017).
9. Denisov K.S., Rozhansky I.V., **Averkiev N.S.**, Lähderanta E., A nontrivial crossover in topological hall effect regimes, *Scientific Reports*. **7**, 17204 (2017).
10. Богословский Н.А., Петров П.В., Иванов Ю.Л., **Аверкиев Н.С.**, Цэндин К.Д., Влияние кулоновских корреляций на люминесценцию и поглощение в компенсированных полупроводниках, *ФТП* **50**, 905 (2016)
11. Гуткин А.А., **Аверкиев Н.С.** .Анизотропные ян-теллеровские акцепторы, создаваемые в GaAs элементами первой группы с заполненной d-оболочкой (О б з о р)*ФТП* **51**,1299(2017)